

# RF-E 10

E-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz



## Kurzbeschreibung

Die Elektrode an der Unterkante des Sondenkopfes der RF-E 10 ist ca. 0,2 mm breit. Damit können kleinste E-Feldquellen lokalisiert werden, z.B. 0,1 mm breite Leiterzüge, einzelne IC-Pins an hochpoligen ICs.

Die RF-E 10 ist eine passive Nahfeldsonde. Sie besitzt den gleichen prinzipiellen Aufbau wie die Sonden RF-E 05 und RF-E 02. Die Auflösung der RF-E 10 ist jedoch wesentlich höher. Typischerweise wird der Sondenkopf direkt auf das Messobjekt aufgesetzt (hohe elektrische Feldstärke). Für Messungen in größeren Abständen wie sie mit der RF-E 05 und der RF-E 02 ausgeführt werden, ist sie nicht geeignet. Die E-Feldsonde ist klein und handlich. Sie besitzt eine Mantelstromdämpfung und die Oberseite des Sondenkopfes ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50  $\Omega$  Eingang angeschlossen. Die E-Feldsonde besitzt intern keinen 50  $\Omega$  Abschlusswiderstand.

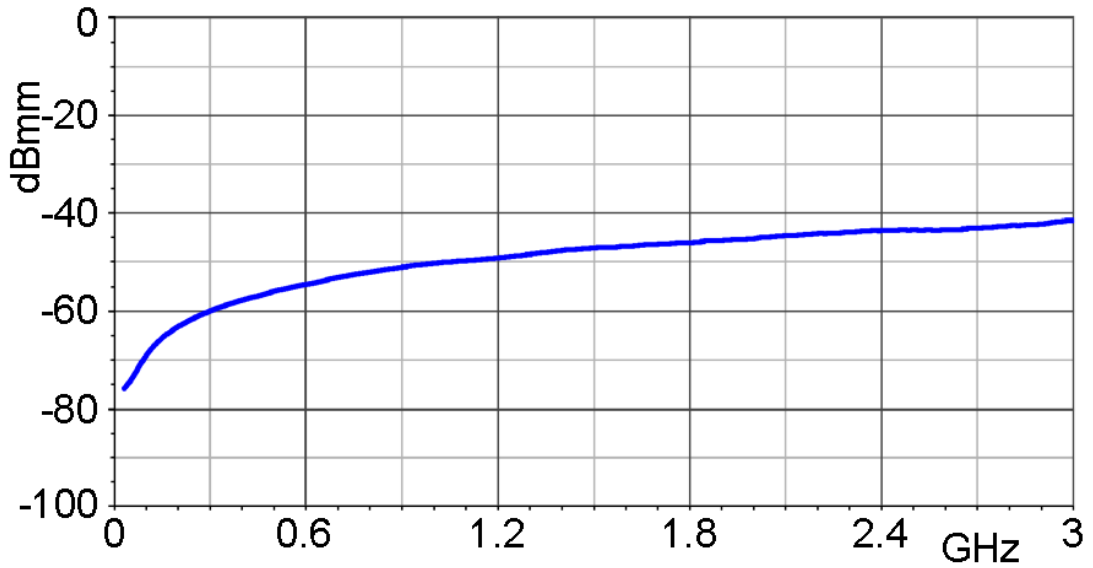
## Technische Parameter

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Frequenzbereich     | 30 MHz ... 3 GHz            |
| Auflösung           | $\approx 0.2$ mm            |
| Maße Sondenkopf     | $\approx (0.5 \times 2)$ mm |
| Anschluss - Ausgang | SMB, male, jack             |
| Gewicht             | 15 g                        |

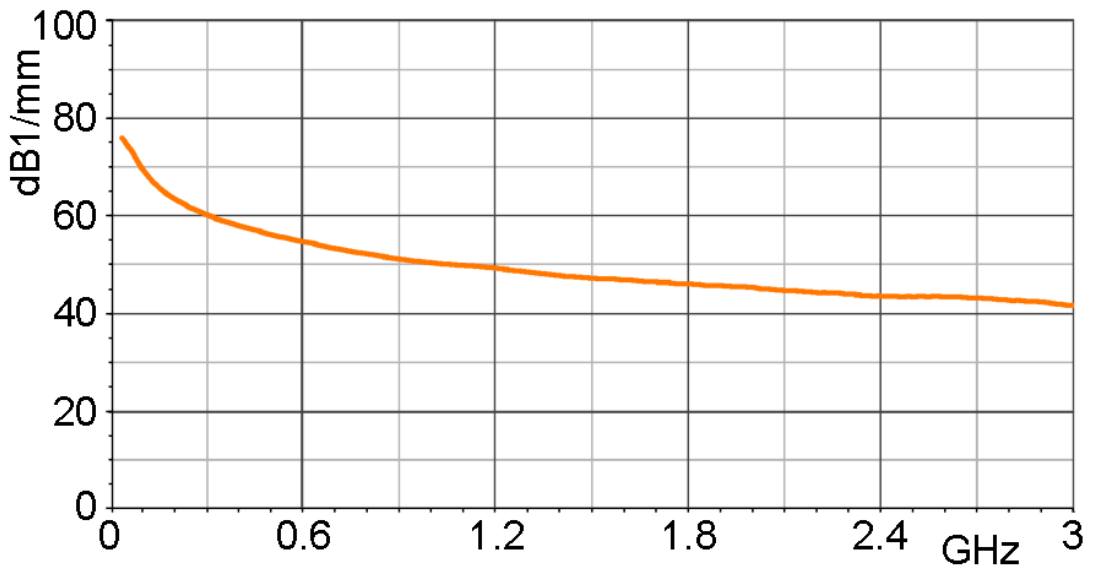
# RF-E 10

E-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

Frequenzgang [dB $\mu$ V] / [dB $\mu$ V/mm]



Korrekturkurve E-Feld [dB $\mu$ V/mm] / [dB $\mu$ V]



# RF-E 10

E-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

## Messprinzip



## Sondenkopf

